

- 16.15 – 16.25 Доклад «Full-Bridge Phase-Shifted Converter Design for Aircraft Rectifier Unit». Докладчик Сергей Валерьевич Луфт (НГТУ, г. Новосибирск).
- 16.25 - 16.40 **Перерыв (зал В).**
- 16.40-16.50 Доклад «The Study of Cross Coupling Compensation Considering the Influence of Controller's Discrete Nature». Докладчик Денис Владимирович Макаров (НГТУ, г. Новосибирск).
- 16.50-17.00 Доклад « Investigation of Three Phase Two-Zone Thyristor AC Voltage Regulator with Capacitor Divider». Докладчик Алексей Вячеславович Удовиченко (НГТУ, г. Новосибирск).
- 17.00-17.10 Доклад «High-voltage Power Supply System of Low-orbit Spacecraft». Докладчик Мария Михайловна Черная (ТУСУР, г. Томск).
- 17.10-17.20 Доклад «Electromagnetic Moment of BLDC with Nonmagnetic Anchor under 180-Degree Commutation». Докладчик Сахбон Алиевич Саидов (НГТУ, г. Новосибирск).
- 17.20-17.30 Доклад «Extraction Algorithm of Symmetrical Components for Controlling Static Converters of Electric Energy». Докладчик Павел Николаевич Смирнов (НГТУ, г. Новосибирск).
- 17.30-17.40 Доклад «Cascaded Control System Design for a Cuk Converter via Singular Perturbation Approach». Докладчик Ефим Андреевич Аксенов (НГТУ, г.Новосибирск).
- 17.40-17.50 Доклад «The Pump Current Pulse Generator for Laser Diodes». Докладчик Кирилл Константинович Копылов (НГТУ, г.Новосибирск).
- 17.50-18.00 Доклад «Power Losses and Thermal Modeling of AC Buck Converters». Докладчик Роман Горбунов (НИ ТПУ, г. Томск).
- 18.00-18.10 Доклад «Modified scheme of high-voltage buck DC-DC converter for electric locomotive». Докладчик Павел Валерьевич Козлов (НГТУ, г. Новосибирск).

### Зал В

- 14.45 – 14.55 Открытие Секция 1 «Физика и технология полупроводников». Руководитель – д.т.н., проф. Виктор Алексеевич Гридчин, НГТУ, г. Новосибирск.
- 14.55 – 15.05 Доклад «Substrates and Coating for Graphene Based Devices». Докладчик Екатерина Витальевна Базылева (НГТУ, г.Новосибирск).
- 15.05 – 15.15 Доклад «Viscous Damping Influence on Dynamic Characteristics in MEMS Variable Capacitor». Докладчик Кирилл Е. Блум (ООО СиБИС, г. Новосибирск).
- 15.15 – 15.25 Доклад «Quantization Noise Influence on Mobility Spectrum Method». Докладчик Александр Владимирович Трифанов (ИФП СО РАН, г. Новосибирск).
- 15.25 – 15.35 Доклад « Mechanisms of Surface Morphology Formation During Ge Growth on Si(100) at High Temperatures». Докладчик Анастасия Евгеньевна Будажапова (НГТУ, г.Новосибирск).
- 15.35 – 15.45 Доклад «A Study of 3D Boss Structure Formation in Anisotropic Etching of Si (100) in Aqueous KOH». Докладчик Артем Сергеевич Чернов (ООО СиБИС, г. Новосибирск).
- 15.45 – 15.55 Доклад « Analysis of GaAs Surface Etching During Droplet Epitaxy Process (Monte Carlo Simulation)». Докладчик Максим Анатольевич Василенко (НГТУ, г.Новосибирск).
- 15.55 – 16.05 Доклад «2D silicon nanopillars arrays for photonics». Докладчик Людмила Сергеевна Голобокова (ИФП СО РАН, г.Новосибирск).
- 16.05 – 16.15 Доклад «Formation And Characterization Of Au-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Native Oxide-HgCdTe Structures». Докладчик Евгений Рашитович Закиров (ИФП СО РАН, г.Новосибирск).
- 16.15 – 16.25 Доклад «Features of Hg<sub>x</sub>-1CdxTe Anodic Sulfidization». Докладчик Дмитрий Евгеньевич Ипатов (НГТУ, г.Новосибирск).
- 16.25 - 16.40 **Перерыв (зал В).**
- 16.40 - 16.50 Доклад «Sentaurus TCAD for Modeling of the Elements of the Matrix Photodetectors on Organic Compounds». Докладчик Оксана Николаевна Каширская (ИФП СО РАН, г.Новосибирск).
- 16.50 - 17.00 Доклад «Self-Organized Low Density SiGe Quantum Dot Molecules». Докладчик Полина Кучинская (ИФП СО РАН, г. Новосибирск).
- 17.00 - 17.10 Доклад «A Solar Cell, Based on the Epitaxial Layers of AlIIIbV Compounds, Transferred from the Substrate onto the Flexible Polymeric Carrier». Докладчик Дмитрий Леган (ИФП СО РАН, г. Новосибирск).
- 17.10 - 17.20 Доклад «Magnetotransport Features of Two-Dimensional Electron Gas on Cylindrical Surface Exposed to Microwave Radiation». Докладчик Денис Борисович Султанов (ИФП СО РАН, г. Новосибирск).
- 17.20 - 17.30 Доклад « Electromagnetic Properties of MWNT, Correlation of Structure Characteristics with Electrophysics Properties ». Докладчик Евгений Юрьевич Коровин (ТГУ, г. Томск).
- 17.30 – 17.40 Доклад « GaAs MBE on Vicinal Substrates Si (001): Impact of Nucleation and Growth Conditions on Crystallographic Properties of the Epitaxial Layers ». Докладчик Михаил Олегович Петрушков (ИФП СО РАН, г. Новосибирск).